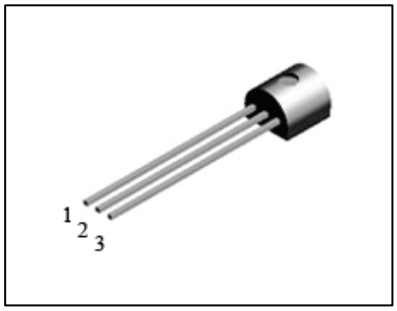
КТ503
кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
n-p-n транзистор

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения.

Зарубежный прототип

- Прототип KSC815



Обозначение технических условий

- аАО. 336.183 ТУ / 02

Особенности

- Диапазон рабочих температур от - 45 до + 100°С
- Комплиментарная пара КТ502

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	База
№3	Коллектор

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ503 при $T_{окр. среды}$ = 25 °С

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Гр. напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо гр.	В	Iк=10mA, Iб=0	25-80	
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Uкб= Uкб max		1
Статический коэффициент передачи тока	h_{21E}		Uкэ=5В, Iк=10 мА	40	240
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ(нас)	В	Iк=10 мА, Iб=1 мА		0,6
Напряжение насыщения база-эмиттер	Uбэ(нас)*	В	Iк=10 мА, Iб=1 мА		1,2
Граничная частота коэф. передачи тока	fгр. *	МГц	Uкб= 5В, Iэ=-3 мА	5	
Емкость коллекторного перехода	Ск *	пФ	Uкб= 5В, f=1МГц		50

* Справочные параметры

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ503

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	40-100
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэ max	В	25-80
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	150
Импульсный ток коллектора (tи ≤ 10 мс, Q ≥ 10)	Iки max	мА	100
Рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	мВт	300
Температура перехода	Tj	°С	350

Таблица 3. Классификация КТ503

	КТ503А	КТ503Б	КТ503В	КТ503Г	КТ503Д	КТ503Е
Uкб max, В	40	40	60	60	80	100
Uкэ max, В	25	25	40	40	60	80
Uкэо гр.	25	25	40	40	60	80
h21e	40-120	80-240	40-120	80-240	40-120	40-120